
全体スケジュール

2022 年度 応用物理学会中国四国支部

若手半導体研究会

全体スケジュール

8 月 22 日(月)

13:00 - 13:10	開会の言葉
13:10 - 13:50	特別講演 1 : 神垣良昭先生 (E & B リサーチ研究所) 「ナイトライド膜内の電荷捕獲中心を用いる MNOS 不揮発性メモリ素子」
13:50 - 14:10	休憩 (20 分)
14:10 - 14:55	ポスターセッション A (11 件)
14:55 - 15:10	休憩 (15 分)
15:10 - 15:55	ポスターセッション B (11 件)
15:55 - 16:10	休憩 (15 分)
16:10 - 16:50	特別講演 2 : 秋山英文先生 (東京大学物性研究所) 「量子細線および利得スイッチレーザーの性能を支配する半導体非線形性」
16:50 - 17:00	閉会の言葉

ポスターセッション A (14:10-14:55)

A-1	ブース#1	N極性面上AlGaIn/AIn電界効果トランジスタの背景及び、試作	齊藤 俊介	山口大学工学部電気電子工学科
A-2	ブース#2	分子線エピタキシー法により作製したZnSTeの光学特性の評価	塩見 将真	鳥取大学大学院工学研究科 情報エレクトロニクス専攻
A-3	ブース#3	温度変調型集電流測定による原子価互変異性Co錯体の集電特性	池長 志紋	岡山理科大学大学院理学研究科
A-4	ブース#4	サファイア基板上N面AlGaIn/AInヘテロ構造の電気的特性	松村 航	山口大学大学院創成科学研究科
A-5	ブース#5	SiドーピングによるN極性AlN/AlGaInの高品質化	藤井 開	山口大学工学部電気電子工学科
A-6	ブース#6	シリコン光集積回路路上に実装した周波数フィルターの評価	山下 普暉	香川大学創造工学部創造工学科
A-7	ブース#7	MOVPE超高温成長中断アニーリングによるAlN転位低減手法	藤田 将希	徳島大学理工学部理工学科電気電子システムコース
A-8	ブース#8	MOCVDによるInGaInの高品質化	佐々木 彩乃	山口大学大学院創成科学研究科
A-9	ブース#9	スペクトル干渉法による電子型強誘電体 α -(BEDT-TTF) ₂ I ₃ の屈折率の温度依存性解析	勝呂 朋世	岡山理科大学大学院理学研究科応用物理学専攻
A-10	ブース#10	Si基板上に成長したGaIn/Siヘテロpn接合における整流特性と発光特性	桑野 貴斗	香川大学創造工学部創造工学科
A-11	ブース#11	X線回折を用いたステップバンチングの発生オフ角評価	藤井 澁樹	徳島大学理工学部理工学科電気電子システムコース

ポスターセッション B (15:10-15:55)

B-1	ブース#1	アークプラズマを用いた酸素負イオン照射による酸化膜の低温形成	前原 誠	住友重機械工業株式会社 産業機器事業部
B-2	ブース#2	ZnSe系有機-無機ハイブリッド型紫外APDの増倍層膜厚の最適化	又野 陸哉	鳥取大学院 持続性社会創生科学研究科
B-3	ブース#3	非極性p型ZnMgO:N薄膜のMBE成長	後藤 憲徳	鳥取大学院 持続性社会創生科学研究科
B-4	ブース#4	ZnSe系有機-無機ハイブリッド型紫外APDアレイの開発	近添 大輝	鳥取大学院 持続性社会創生科学研究科
B-5	ブース#5	ガラス基板上でのZnOの極性制御	川村 鮎人	高知工科大学 システム工学群 電子・光工学専攻
B-6	ブース#6	MOCVD法で成長したc面InGaInの品質改善	俵迫 湧也	山口大学大学院創成科学研究科
B-7	ブース#7	水素及び酸素プラズマ処理による β -Ga ₂ O ₃ のドナー密度変化	水田 未羽	岡山大学
B-8	ブース#8	GaN-Cap層が緑色InGaIn量子井戸構造の光学特性に与える影響	服部 竜吾	山口大学大学院創成科学研究科
B-9	ブース#9	N極性面上AlGaIn/AIn電界効果トランジスタの性能改善と特性評価方法	金崎 蓮	山口大学工学部電気電子工学科
B-10	ブース#10	低転位 AlN テンプレート上 AlGaIn 量子井戸構造における内部量子効率の量子井戸数依存性	稲井 滉介	山口大学大学院創成科学研究科
B-11	ブース#11	多結晶Si中Ni関連準位消滅過程の2状態モデルによる解析	寺田 唯人	岡山大学大学院自然科学研究科